



MD 3692 G2 2008.08.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **3692** ⁽¹³⁾ **G2**

(51) Int. Cl.: *H01L 35/28* (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 30/00 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2007 0121 (22) Data depozit: 2007.04.28	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2008.08.31, BOPI nr. 8/2008
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
(72) Inventatori: BODIUL Pavel, MD; GHIȚU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; POPOV Ion, MD	
(73) Titular: INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	

(54) **Termoelectrod pentru traductor termoelectric**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la tehnica electronică și poate
fi utilizată pentru confecționarea termoelectrozilor
pentru traductoare termoelectrice.

Termoelectrodul este executat din material
semiconductor anizotrop în formă de fir în izolație
de sticlă. Totodată firul este confecționat din com-

2
pusul bismut-stibiu dopat cu staniu în următorul
raport: staniu 0,01...0,03% at., stibiu 10...15% at.,
bismut restul.

Revendicări: 1

10

MD 3692 G2 2008.08.31

MD 3692 G2 2008.08.31

3

Descriere:

Invenția se referă la tehnica electronică și poate fi utilizată la fabricarea termoelectrozilor pentru traductoare termoelectrice.

5 Cea mai apropiată soluție este termoelectrodul din material semiconductor anizotrop cu două tipuri de purtători de sarcină, executat în formă de fir în înveliș de sticlă. Firul se obține din material semiconductor anizotrop, în bază de bismut cu adaos de stibiu și plumb în următorul raport: 12% at. Sb, 0,3% at. Pb [1].

Neajunsurile acestui termoelectrod sunt conductibilitatea electrică joasă, deoarece eficacitatea plumbului este de trei ori mai mică decât eficacitatea stibiului, precum și fragilitatea lor.

10 Problemele pe care le rezolvă invenția constau în asigurarea eficacității înalte de transformare termică și micșorarea fragilității.

Termoelectrodul, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că este executat din material semiconductor anizotrop în formă de fir în izolație de sticlă, firul fiind confecționat din compusul bismut-stibiu dopat cu staniu în următorul raport, % at.:

15 staniu 0,01...0,03
stibiu 10...15
bismut restul.

Rezultatele invenției constau în obținerea ramurii n cu o valoare maximă a forței termoelectromotoare negative și sporirea durtității mecanice a termoelectrodului.

20 Este cunoscut faptul că pentru mostrele masive ale aliajelor de $Bi_{1-x}Sb_x$, unde $0 \leq x \leq 0,25$, este caracteristică creșterea rezistenței concomitent cu mărirea concentrației stibiului. Caracteristica dependenței rezistenței de temperatură a aliajului $Bi_{1-x}Sb_x$ pentru $x \leq 0,07$ este asemănătoare metalelor, iar odată cu creșterea concentrației de stibiu este asemănătoare semiconductorilor (trecerea semimetal-semiconductor). Când concentrația stibiului atinge valoarea de 20%, materialul trece iarăși în starea semimetal, posedând proprietăți semimetalice. Acest fapt indică la aceea că aliajele de bismut-stibiu în limitele concentrațiilor $0,07 \leq x \leq 0,20$ posedă proprietăți semiconductoare. Aceeași dependență de temperatură a rezistenței este depistată la obiectele dimensional reduse (fire subțiri în izolație de sticlă), care posedă structură cristalografică ideală, cu diametrul de 0,3 μ m și mai mult. În firele subțiri de bismut se observă o dependență termică caracteristică semiconductorilor, datorită efectului dimensional mărginit clasic. În aliajele de $Bi_{1-x}Sb_x$ ($0,08 \leq x \leq 0,2$) valoarea rezistenței relative $\rho(T \sim 4,2K)$ începe să scadă, iar dependența sa de temperatură devine mai puțin pronunțată. Fenomenul dat se explică prin creșterea concentrației purtătorilor de sarcină în urma deformării zonei interzise din apropierea suprafeței. Cu cât este mai mică grosimea firelor, cu atât mai puternic se evidențiază efectul dat și cu atât mai mare este concentrația purtătorilor de sarcină. Pentru firele de $Bi_{1-x}Sb_x$ ($0,08 \leq x \leq 0,2$) cu grosimea 0,7 μ m și mai puțin este caracteristică absența proprietăților semiconductoare la temperaturi joase.

Exemplu de realizare a invenției

40 În calitate de componente inițiale pentru obținerea cristalelor anizotrope masive au servit ВН-000 (Bi-99,9999), Сy-Экспа (99,9999), staniu de marca OB4-000 (99,9999). Aliajele de $Bi_{1-x}Sb_x$, dopate cu staniu au fost obținute în procesul de mișcare a sobei cu viteză de 0,5 mm/h. Apoi, din soluția solidă, prin metoda Ulitovski, au fost obținute fire subțiri în izolație de sticlă cu diametrul 1 μ m, care sunt în continuare utilizate în calitate de termoelectrozi. Aceștia din urmă au fost supuși măsurătorilor termoelectrice. În tabelul 1 sunt prezentați parametrii de bază ai firelor cu diverse concentrații de stibiu.

45

Tabelul 1

Nr. d/o	Bi, % at.	Sb, % at.	Sn, % at.	α , μ V/K
1	80	20	0,03	-168
2	85	15	0,03	-182
3	88	12	0,03	-185
4	90	10	0,03	-180
5	95	5	0,03	-175

Pentru determinarea durtității la întindere mecanică a firelor în izolație de sticlă s-a folosit instalația de măsurare a proprietăților mecanice ale corpurilor solide.

50 Calculul tensiunii de rupere a fost efectuat după formula

$$\sigma_R = \frac{P}{NS},$$

unde P este forța medie maximală pe care o suportă probele de același diametru;

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2007 0121	
(22) Data depozit: 2007.04.28	
(51) : Int.Cl: <i>H01L 35/28</i> (2006.01) <i>H01L 35/18</i> (2006.01) <i>C01G 29/00</i> (2006.01) <i>C01G 30/00</i> (2006.01) <i>C01G 19/00</i> (2006.01)	
Alți indici de clasificare: H01L	
(54) Titlul : Termoelectrod pentru traductor termoelectric	
(71) Solicitantul : INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
Termeni caracteristici :	
a) limba română : termoelectrod, traductor	
b) limba engleză: thermoelectrode, converter	
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)	
Int. Cl. ⁷ H01L	
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)	
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)	
MD perioada 1993-2007.04; EA 1996-2007.04; SU 1972-1994	

IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	EA 2073 12.24.2001	1
A	EA 4668 06.24.2004	1
A	SU 1253358 A1 1996.01.10	1
A	SU 463008 A1 1975.03.05	1
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția

E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data	X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)	Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare	& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării	23.06.2008
Examinatorul	Valeriu Ciorbă